

广东省粤晶高科股份有限公司

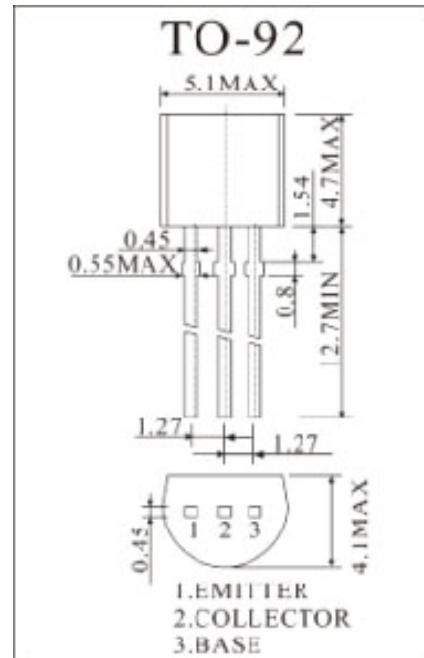
C380

—NPN silicon—

■ ■ 主要用途：高频放大等。

■ ■ 绝对最大额定值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	额定值	单 位
集电极—基极电压	V_{CBO}	35	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	30	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	4	V
集电极电流	I_c	50	mA
集电极耗散功率	P_c	300	mW
结 温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	- 55~150	$^{\circ}\text{C}$



■ ■ 电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
直流电流增益	h_{FE}	40		240		$V_{\text{CE}}= 12 \text{ V}, I_c= 2 \text{ mA}$
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			0.1	$\mu \text{ A}$	$V_{\text{CB}}= 35 \text{ V}, I_E= 0$
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			0.1	$\mu \text{ A}$	$V_{\text{EB}}= 4 \text{ V}, I_c= 0$
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	35			V	$I_c= 0.1 \text{ mA}, I_E= 0$
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	30			V	$I_c= 1 \text{ mA}, I_B= 0$
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	4			V	$I_E= 0.1 \text{ mA}, I_c= 0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{\text{CE(sat)}}$			0.4	V	$I_c= 10 \text{ mA}, I_B= 1 \text{ mA}$
基极-发射极电压	V_{BE}			1.0	V	$I_c= 10 \text{ mA}, I_B= 1 \text{ mA}$
电流增益-带宽乘积	f_t	100	300		MHz	$I_c= 1 \text{ mA}, V_{\text{CE}}= 10 \text{ V}$
共基极输出电容	C_{ob}		2.0	3.2	PF	$V_{\text{CB}}= 10 \text{ V}, I_E= 0, f = 1 \text{ MHz}$
功率增益	K_p	27	29	33	dB	$V_{\text{CB}}= 6 \text{ V}, I_E= -1 \text{ mA}, f = 10.7 \text{ MHz}$

■ ■ h_{FE} 分档及其标识志

分 档	R	O	Y
h_{FE}	40~80	70~140	120~240